Measurement of the beam energy spread at the JAEA AVF cyclotron

Susumu Okumura¹, Satoshi Kurashima, Nobumasa Miyawaki, Hirotsugu Kashiwagi, Ken-ichi Yoshida,

Ikuo Ishibori, Yosuke Yuri, Takayuki Nara, Takashi Agematsu

Japan Atomic Energy Research Institute

1233 Watanuki, Takasaki, Gunma 370-1292, Japan

Abstract

The energy spread of the beam extracted from the JAEA AVF cyclotron was measured with a simple analyzing system, including the existing deflecting magnet system in the transport line. A test was conducted to prove the analyzing system by comparing energies measured with a semiconductor detector. The beam energy spread for single-turn extraction was measured and was half of the one for multi-turn extraction.

原子力機構AVFサイクロトロンビームのエネルギー幅計測

1.はじめに

原子力機構AVFサイクロトロンでは、4連四重極 レンズを用いたビーム集束方式によって、数百MeV 級重イオンマイクロビーム形成を目指している[1]。 レンズでの色収差の影響を抑制して1µm以下の ビーム径及び照準位置精度を達成するためにはビー ムエネルギー幅を従来の0.1%程度から0.02%へ縮小 化する必要がある。そこで、フラットトップ加速^[2] などを用いたエネルギー幅縮小化を進めている。フ ラットトップ加速では、基本波加速電圧に第五高調 波を加えて加速電圧を平坦化するが、ビーム位相を この平坦化領域に制限する必要があり、サイクロト ロン中心領域の2組のビーム位相スリットでビーム 位相を制御するとともにビームバンチャーでビーム 強度を増強している。一方、磁場変動によるビーム 位相変化を抑制するために、サイクロトロン電磁石 の鉄心温度安定化を実施し、許容磁場変動率 B/B =±1×10⁻⁵以内をすでに達成している^[3]。本AVFサイ クロトロンでは、従来はビーム引き出し直前の半径 方向のビーム分布が連続分布(マルチターン)で あったが、上記のエネルギー幅縮小化によってター ンの分かれた分布(シングルターン)を実現した^[4]。

ビームエネルギー幅縮小化を確認するために、 ビーム輸送系に設置されている分析電磁石を用いた 計測システムを開発した。本報告では、本計測シス テムの性能評価、およびシングルターン引き出し ビームのエネルギー幅計測結果について述べる。

2. エネルギー幅計測システム

2.1 ビーム輸送光学系

図1にサイクロトロン出口下流のビーム輸送系を 示す。サイクロトロンから出たビームは、三連四極 電磁石による集束を受け、最初の集束点CSOへ輸送 され、次に四連四極電磁石によって集束点TS1へと



図1:サイクロトロン出口下流のビーム輸送系

輸送される。軽イオン大電流照射のために設けられ た直線輸送コースを除いて、ビームは三連四極電磁 石、80度偏向の分析電磁石、四極電磁石から構成さ れる分析電磁石系によって集束点TS2へ輸送され、 その下流のスイッチング電磁石で各照射室へと分配 される。ビーム強度などのビーム特性は各集束点に 設置されたビーム診断ステーションでモニタしてい る。TS1からTS2の分析電磁石系でエネルギー分析を 行い、NMR磁場測定装置で得た分析電磁石の磁場の 値から、ビームエネルギーを算出している。ただし、 絶対値較正は、飛行時間法によるエネルギー計測を 末端の実験ポートで実施している^[5]。

2.2 計測原理

ビームエネルギー幅計測では、分析電磁石系での 運動量分散によるビームの拡がりを利用している。 分析電磁系の運動量分解能を評価するために、以下 の第一次近似の表式を用いた^[6]。

¹ E-mail: okumura.susumu@jaea.go.jp

運動量高分解能化を進めるためには微小なスリット幅が必要となるため、スリット端面での散乱が問題となる。そこで、マイクロビーム形成に用いられている円柱形ロッドを用いたマイクロスリットを開発し、ビームエネルギー幅計測システムを構築した。オブジェクト位置TS1からイメージ位置TS2の分析電磁石系の分散Dと拡大率Mを計算コードTRANSPORTで求めたところ、D = 2mm/(1×10⁻³)、M = -1であった。今回使用したオブジェクトおよびイメージスリット幅は共に100µmであるため、エネルギー分解能は、式(1)、(2)および E/E=2 P/Pの関係より E/E = 1×10⁻⁴である。

2.3 システム構成

本計測システムは、オブジェクト位置TS1用マイ クロスリット(TS1マイクロスリット)およびイ メージ位置TS2用のマイクロスリット (TS2マイクロ スリット)、マイクロスリットを通過したイオンを 検出する半導体検出器およびその検出信号処理系、 マイクロスリット駆動制御系で構成されている(図 2)。TS1マイクロスリットのスリット幅に対する イメージサイズの拡がりを求めるために、TS2マイ クロスリットを走査しながらTS2各位置での検出イ オンカウント数を記録する。計測・駆動制御プログ ラムにはLabVIEW(National Instruments製)を用い、 PCと機器との接続にはGPIBを使用している。サイク ロトロン本体室に設置しているのは、マイクロス リット駆動用モーターコントローラ(PMC - 6GR:神 津精機製)と半導体検出器用プリアンプで、その他 は制御室に設置している。モーターコントローラの 遠隔通信には、イーサーネット経由で容易にGPIB接 続が可能なGPIB-ENET/100(National Instruments 製)を使用している。



図2:ビームエネルギー幅計測システム概略図



図4:半導体検出器のエネルギースペクトル

3.計測システムの性能評価

分析電磁石系で設計通りにビーム輸送が行われ、 計測システムで予定通りの性能が出ているかを確認 するために、半導体検出器で計測したビームエネル ギー(相対値)を用いた性能評価を実施した。図3 は、位置を固定したTS1マイクロスリットを通過し たビームについて、TS2マイクロスリットを走査し て計測したTS2でのビーム強度分布で、ビームエネ ルギーの広がりを表している。領域全体を網羅する ようにこの分布から代表点を選び、そのTS2マイク ロスリット位置について、半導体検出器でエネル ギースペクトル計測を実施した。図4はTS2マイク ロスリット位置-4.2mmでの半導体検出器のエネル ギースペクトルで、ピーク位置は3787.1chであった。 このピーク位置E₀を基準として、各ピーク位置の偏 差の割合 E/E = (E - E₀) / E₀とTS2マイクロス リット位置Xとの関係を図5に示す。直線フィッ

ティングより傾き (E/E)/ X = 1.1×10⁻³/mmが 得られ、これは分散Dより求めた理論値1.0×10⁻³/mm にほぼ一致している。



図5:半導体検出器ピーク位置偏差の割合と TS2マイクロスリット位置との関係



図6:シングルターン引き出し時のエネル ギー幅

4.エネルギー幅計測結果

260MeV ²⁰Ne⁷⁺ビームにおいて実現しているシング ルターン引き出し時のビームエネルギー幅計測を実 施した。その結果、シングルターン引き出しでは 0.05%、全体磁場をわずかにずらしてマルチターン 引き出しとした場合には0.1%のエネルギー幅が得ら れた。図6にシングルターン引き出し時のイメージ 位置でのビーム分布を示す。ビーム全体に対するエ ネルギー幅を算出するために、複数のオブジェクト 位置に対するイメージ位置でのビーム分布を足し合 わせている。

5.まとめ

分析電磁石を用いたビームエネルギー幅計測シス テムを構築した。半導体検出器で得られたエネル ギースペクトルを用いてその性能を評価し、設計通 りであることを確認した。本システムによって、サ イクロトロンで加速したビームのエネルギー幅計測 を行い、シングルターン引き出し時のビームエネル ギー幅が、通常のマルチターン引き出し時のビーム エネルギー幅より小さいことが確認できた。目標の エネルギー幅0.02%を達成するために、本システム を用いてビームエネルギー幅計測を行い、サイクロ トロンパラメータのさらなる最適化を進める予定で ある。

参考文献

- M. Oikawa, T. Kamiya, M. Fukuda, S. Okumura, H. Inoue, S. Masuno, S. Umemiya, Y. Oshiyama, Y. Taira, Nucl. Instr. and Meth. B210, 54 (2003).
- [2] M. Fukuda, S. Kurashima, S. Okumura, N. Miyawaki, T. Agematsu, Y. Nakamura, T. Nara, I. Ishibori, K. Yoshida, W. Yokota, and K. Arakawa, Rev. Sci. Instrum. 74 (4), 2293 (2003).
- [3] S. Okumura, K. Arakawa, M. Fukuda, Y. Nakamura, W. Yokota, T. Ishimoto, S. Kurashima, I. Ishibori, T. Nara, T. Agematsu, M. Sano, T. Tachikawa, Rev. Sci. Instrum. 76, 033301 (2005).
- [4] S. Kurashima, N. Miyawaki, S. Okumura, I. Ishibori, K. Yoshida, H. Kashiwagi, M. Fukuda, Y. Nakamura, T. Agematsu and Y. Nakamura, TIARA Annual Report 2004, JAEA-Review 2005-001, 349-351 (2006).
- [5] S. Okumura, S. Kurashima, N. Miyawaki, K. Yoshida, and M. Fukuda, Rev. Sci. Instrum. 76, 113106 (2005).
- [6] H. A. Enge, Focusing of Charged Particles, ed. A. Septier (Academic Press, 1967), Vol. II, 203-264.